

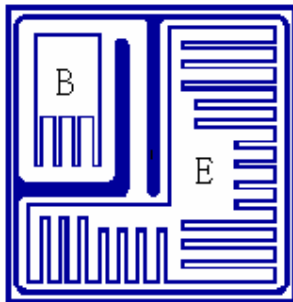
TIP112

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 ")

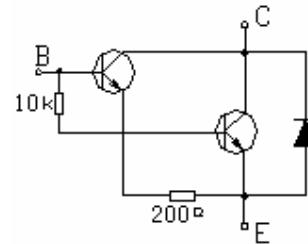
■用途

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■芯片示意图



■内部结构:



■芯片结构

芯片尺寸	1800 μ m × 1800 μ m
焊区尺寸	基区 380 μ m × 470 μ m 发射区 380 μ m × 530 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
芯片厚度	240 ± 10 μ m
金属层	正面: Al 3.1 ± 0.3 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C =0.1mA, I _E =0	260	210		V
集电极--发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =10mA, I _B =0	150	100		V
集电极--发射极维持电压	V _{CEO (sus)} *	I _C =30mA, I _B =0		100		V
发射极--基极击穿电压	BV _{EBO}	I _B =1mA, I _C =0		8		V
集电极--基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =100V, I _E =0			1	μ A
集电极-发射极截止电流	I _{CEO}	V _{CE} =100V, I _B =0			1	μ A
发射极--基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =10V, I _C =0	1		1.25	mA
直流电流增益	h _{FE1}	V _{CE} =3V, I _C =0.5A		1000	15000	
直流电流增益	h _{FE2}	V _{CE} =5V, I _C =2A	4000	2000	15000	
集电极--发射极饱和电压	V _{CES}	I _C =3A, I _B =12mA	1.3		1.8	V

* V_{CEO (sus)}: 脉宽≤300 μ s, 占空比≤2% (TO—220)